'S/3,DS,BA/ALL >>Item list not allowed with accession number T S1/3.DS.BA/ALL 1/3.DS,BA/1MIALOG(R)File 352:Derwent WPI c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv. 111642242 'PI Acc No: 1998-059150/199806 RAM Acc No: C98-020434 RPX Acc No: N98-047053 Glyoxime group esters used as acid generating agents for resists containing e.g. cycloalkyl, aryl or hetero-aryl gps. and preferably bis(camphorsulphonyl)nioxime derivative 'atent Assignee: SUMITOMO CHEM CO LTD (SUMO) lumber of Countries: 001 Number of Patents: 001 'atent Family: 'atent No Kind Date Applicat No Kind Date Week IP 9301948 19971125 JP 96113473 Α 19960508 199806 B Α 'riority Applications (No Type Date): JP 96113473 A 19960508 'atent Details: 'atent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes IP 9301948 6 C07C-309/65 Α ibstract (Basic): JP 9301948 A Glyoxime gp. esters of formula (I) are new. Q1, Q2 = H, alkyl, cycloalkyl, aryl, hetero-aryl, or ring as Q1+Q2. USE - (I) are used as acid-generating agents for resist compsns. contg. alkali-soluble resin having protective gp. cleavable by acid action and acid-generating agents.

ADVANTAGE - (I) are useful especially as acid-generating agents for resist contg. alkali-soluble resin having protective gp. cleavable by acid action. The resist compsns. using (I) as acid-generating agents have a high level of thermal resistance, residual membrane rate, and coating character and have excellent sensitivity, resolution, and profile; time delay effect is also suppressed.

Dwg.0/0

(11)特許出願公開番号

特開平9-301948

(43) 公開日 平成 9年 (1997) 11月25日

(51) Int. Cl. " C07C309/65	識別記号	7419-4H	F I CO7C309/65	-	技術表示箇所		
303/28		7419-4H	303/28		**		
CO9K 3/00	500		CO9K 3/00	500	K		
G03F 7/004	503		G03F 7/004	503			
HO1L 21/027			HOIL 21/30	502	R		
			審査請求。未	未請求 請求項の数	t5 OL	(全6頁)	
(21) 出願番号	特願平8-113473		(71) 出願人 000	0002093			
				友化学工業株式会:	} 		
(22) 出願日	平成8年(1996)5月8日			阪府大阪市中央区:		5 番33号	
			(72) 発明者 富岡 淳				
				版市此花区春日出·	中3丁目1	番98号 住	
			}	化学工業株式会社			
			(72) 発明者 尾崎		-		
				阪市此花区春日出	≠3丁目1.	番98号 住	
			1	化学工業株式会社		2003	
				理士 久保山 隆	•)	
		·	(1.7) (4.2)		(7) 1 11		

(54) 【発明の名称】グリオキシム系エステル、その製法および用途

(57) 【要約】

【課題】 酸の作用により開裂しうる保護基を有するアルカリ可溶性樹脂を含有するレジスト組成物の酸発生剤として使用できる化合物を提供し、これを用いて諸性能

に優れるレジスト組成物を提供する。

【解決手段】 式(I) で示されるグリオキシム系エステル。

$$CH_2-SO_2-O-N=C-C=N-O-SO_2-CH_2$$

式中、 Q^1 および Q^2 は互いに独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリールもしくはヘテロアリールを表すか、または Q^1 と Q^2 が結合して環を形成する。式(I)のエステルは、対応するグリオキシム系N-O 日体を、10-カンファースルホニルハライドと反応さ

せることにより、製造できる。式 (I) のエステルを酸発生剤として用い、酸の作用により開裂しうる保護基を有するアルカリ可溶性樹脂と配合して、レジスト組成物が得られる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】式(1)

$$CH_2-SO_2-O-N=C-C=N-O-SO_2-CH_2$$

$$Q^1 Q^2$$

$$Q^2 Q^2$$

(式中、 Q^1 および Q^2 は互いに独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、アリールもしくはヘテロアリールを表すか、または Q^1 と Q^2 が結合して環を形成する)で示されるグリオキシム系エステル。

1

【請求項2】O, O′ - (10-カンファースルホニル) ニオキシムである請求項1記載のエステル。

【請求項3】式(11)

$$HO-N=C-C=N-OH \qquad (II)$$

$$\downarrow I \qquad \downarrow Q$$

$$Q^{1} Q^{2}$$

(式中、 Q^1 および Q^2 は請求項1記載の意味を表す)で示されるグリオキシム系化合物と10-カンファースルホニルハライドとを、塩基性触媒の存在下で反応させることを特徴とする、請求項1記載のグリオキシム系エステルの製造方法。

【請求項4】請求項1または2記載のエステルを有効成分とする酸発生剤。

【請求項5】酸の作用により開裂しうる保護基を有する アルカリ可溶性樹脂、および請求項4記載の酸発生剤を 含有することを特徴とするレジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なグリオキシム系エステル、それの製造方法およびそれのレジスト分野への適用に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体集積回路の高集積化に伴って、クォーターミクロンのパターン形成が要求されるようになっている。特に、フッ化クリプトン(KrF) やフッ化アルゴン(ArF) からのエキシマーレーザーを利用するリソグラフィーは、64MDRAMおよび256MDRAMの製造を可能とすることから、注目されている。従来、リソグラフィープロセスには、主として近紫外線が使われていたが、光源の変更に伴い、レジストには、従来からの耐熱性、残膜率、プロファイルなどの諸性能に加えて、新たに次のような性能も要求されるようになっている。

a) KrF やArF エキシマーレーザー光源に対して高感度 であること、および

b) 高解像度であること。

【0003】このような状況のもとで、酸触媒の化学増

幅効果を利用した、いわゆる化学増幅型レジストが提案されている。化学増幅型レジストは、放射線照射により酸発生剤から発生した酸を触媒とする反応によって、露光部のアルカリ現像液に対する溶解性を発現させるものであり、これによってポジ型レジストが得られる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】化学増幅型レジストにおいては、露光によって発生した酸が、露光後の熱処理 (post exposure bake:以下、PEBと略すことがある)によって拡散し、樹脂等の保護基を脱離させるとともに、酸を再生成することにより、高感度を実現しているが、一層の高感度化が望まれており、また解像度の向上も望まれている。さらに、このような化学増幅型レジストには、露光からPEBまでの放置時間によって性能が大きく変化する、いわゆるタイム・ディレイ(lime de lay)効果がある。こうしたタイム・ディレイ効果により、解像度が低下するとともに、現像後のパターンに膜張り現象(Tーシェープ化)や小パターン倒れなど、プロファイルの悪化が起こり、寸法の再現性が損なわれることになる。

【0005】本発明の目的は、酸の作用により開裂しうる保護基を有するアルカリ可溶性樹脂を含有するレジスト組成物の酸発生剤として用いた場合に優れた効果を発揮する新規な化合物を製造し、提供することにある。

30 【0006】本発明の別の目的は、かかる化合物を用いて、耐熱性、残膜率、塗布性などの諸性能を高い水準に維持しつつ、感度、解像度およびプロファイルが改良され、またタイム・ディレイ効果も小さいレジスト組成物を提供することにある。

【0007】本発明者らは、かかる目的を達成すべく鋭意研究を行った結果、グリオキシム系の新規な化合物を見出し、そしてこの化合物を、酸の作用により開裂しうる保護基を有するアルカリ可溶性樹脂とともに配合したレジスト組成物が優れた性能を発揮することを併せて見40出し、本発明を完成した。

[0008]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、次式 (1) で示されるグリオキシム系エステルを提供するものである。

[0009]

$$CH_2-SO_2-O-N=C-C=N-O-SO_2-CH_2$$

$$Q^1 Q^2$$

$$Q^1 Q^2$$

【0010】式中、Q' およびQ' は互いに独立に、水 50 素、アルキル、シクロアルキル、アリールもしくはヘテ

ロアリールを表すか、またはQ'とQ'が結合して環を 形成する。

【0011】式(1)で示されるグリオキシム系エステ ルは、式(11)

[0012]

$$\begin{array}{ccc} \text{HO-N=C-C=N-OH} & (II) \\ & & & \\ & &$$

【0013】 (式中、Q' およびQ' は前記の意味を表 す) で示されるグリオキシム系化合物と10-カンファ ースルホニルハライドとを、塩基性触媒の存在下で反応 させることにより、製造することができる。

【0014】また本発明は、式(1)のグリオキシム系 エステルを有効成分とする酸発生剤を提供し、さらに は、この酸発生剤を、酸の作用により開裂しうる保護基 を有するアルカリ可溶性樹脂とともに配合してなるレジ スト組成物をも提供する。

[0015]

【発明の実施の形態】式 (I) において、Q' およびQ "は互いに独立に、水素、アルキル、シクロアルキル、 アリールもしくはヘテロアリールであるか、またはQ¹ とQ¹ が結合して環を形成する。アルキルは、炭素数1 ~20程度であることができ、なかでも炭素数1~12 程度のものが好ましく、例えば、メチル、エチル、プロ ピルなどが挙げられる。シクロアルキルは、炭素数3~ 7程度であることができ、なかでも炭素数5~7程度の ものが好ましく、例えば、シクロペンチル、シクロヘキ シル、シクロヘプチルなどが挙げられる。アリールは、 炭素数6~18程度であることができ、なかでも炭素数 6~14程度のものが好ましく、例えば、フェニル、ト リル、キシリルなどが挙げられる。またヘテロアリール は、酸素、窒素、イオウのようなヘテロ環原子を1個、 2個または3個含有する炭素数3~20程度であること ができ、なかでも炭素数3~12程度が好ましい。Q' とQ'が結合して環を形成する場合、Q'とQ'の炭素 数の合計は、 $2\sim5$ 程度がよい。この場合、Q'、Q'およびそれらが結合する2個の炭素原子の間で、シクロ アルカン環を形成するのが一般的であり、このシクロア ルカン環からは、さらにアルキルなどが枝分かれしてい

【0016】式(I)で示されるエステルは、式(II) で示されるグリオキシム系化合物と10-カンファース ルホニルハライドとの反応により、製造することができ る。ここで用いる10-カンファースルホニルハライド は、光学活性体でもラセミ体でも構わない。10-カン ファースルホニルハライドを構成するハロゲンは、フッ 素、塩素、臭素、ヨウ素などであることができる。ま た、式(II)のグリオキシム系化合物としては、例え ば、グリオキシム、ジメチルグリオキシム、ベンジルジ ム (別名:シクロヘキサンー1, 2-ジオン ジオキシ ム)などが挙げられる。

【0017】この反応において、10-カンファースル ホニルハライドは、式(II)のグリオキシム系化合物に 対し、一般には 0.7~1.5のモル比、好ましくは 1.1~ 1.2のモル比で用いられる。このモル比が0.7未満にな ると、未反応の原料グリオキシム系化合物が、またモル 比が1.5を越えると、未反応の10-カンファースルホ ニルハライドがそれぞれ多量に残るため、反応後の精製 10 が難しくなる。この反応は塩基性触媒の存在下で行わ れ、塩基性触媒としては、トリエチルアミンのような脂 肪族アミン類、ピリジンのような環状アミン類、炭酸水 素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのような 無機塩基類などが挙げられるが、なかでもトリエチルア ミンやピリジンなどの有機アミン類が好ましく用いられ る。

【0018】式 (II) のグリオキシム系化合物と10-カンファースルホニルハライドとの反応は、極性溶媒中 で行うのが好ましい。ここで用いる極性溶媒としては、 アセトン、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、 1, 3-ジオキソラン、ジメチルホルムアミド、アセト ニトリル、アープチロラクトン、ジメチルスルホキシド のような親水性溶媒の一種または二種以上、ジクロロメ タンやクロロホルムのような疎水性溶媒の一種または二 種以上、イオン交換水や蒸留水を包含する水などが挙げ られる。極性溶媒は、反応原料である式(II)のグリオ キシム系化合物と10-カンファースルホニルハライド の合計に対し、2~10重量倍、さらには4~8重量倍 の範囲で用いるのが好ましい。溶媒の量があまり多いと 反応時間が長くなり、またその量があまり少ないと溶解 度の制限や攪拌動力の問題が生じやすい。

【0019】この反応は、通常20~50℃の範囲の温 度で行われる。温度があまり高いと副反応が起こりやす くなり、また温度があまり低いと反応時間が長くなる。 反応時間は、通常 0.5~5時間程度である。

【0020】反応終了後は、必要に応じて精製すること ができる。例えば、反応後の生成物を、水への溶解度が 9g/100g以下である溶媒に溶解し、水洗分液を行 って金属含量を低減させておくのが好ましい。水への溶 解度が9g/100g以下とは、20℃の水100gに 溶ける最大量が9g以下であることを意味する。この溶 媒は特に、水への溶解度が5g/100g以下であるの が好ましい。このような溶媒としては、例えば、トルエ ン、酢酸エチル、塩化メチレン、n-ヘプタンなどが挙 げられる。

【0021】また、反応により生成した、あるいは上記 のようにして金属分の低減を図った式(1)のエステル は、適当な溶媒から晶析させることができる。ここで用 いる晶析溶媒としては、例えば、四塩化炭素やクロロホ オキシム(別名:ジフェニルグリオキシム)、ニオキシ 50 ルムのようなハロゲン化炭化水素類単独、またはそれを

主体とする混合溶媒、n-ヘプタンやn-ヘキサン、シクロヘキサンのような脂肪族または脂環式炭化水素と、ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素との混合溶媒などが挙げられる。晶析温度は、40℃以下、さらには25℃以下が好ましい。

【0022】かくして得られるグリオキシム系エステルは、式(I)から明らかなように不斉炭素を有し、光学活性体またはラセミ体であることができる。式(I)のエステルとして、具体的には例えば、次のような化合物が挙げられる。

[0024]

【0025】式(I)のグリオキシム系エステルは、レジスト用の酸発生剤、とりわけ、酸の作用により開裂し うる保護基を有するアルカリ可溶性樹脂を含有するレジ

スト組成物に用いられる酸発生剤として、有用である。 【0026】レジスト組成物を構成するアルカリ可溶性 樹脂は、酸の作用により開裂しうる保護基を有する。そ のベースポリマーとしては、フェノール性水酸基を有す るものや、カルボキシル基を有するものが好ましい。具 体的には、フェノールノボラック樹脂;クレゾールノボ ラック樹脂;キシレノールノボラック樹脂;ビニルフェ ノール樹脂;イソプロペニルフェノール樹脂;ビニルフ エノールと、(メタ)アクリル酸もしくはその誘導体、 10 アクリロニトリル、スチレンもしくはその誘導体などと の共重合体;イソプロペニルフェノールと、(メタ)ア クリル酸もしくはその誘導体、アクリロニトリル、スチ レンもしくはその誘導体などとの共重合体;スチレンも しくはその誘導体と、アクリル樹脂、メタクリル樹脂、 アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、無水マレイン 酸、アクリロニトリルなどとの共重合体;これらのポリ マー鎖中にケイ素を含む化合物が導入された樹脂などを 挙げることができる。

【0027】これらのベースポリマーにおける水酸基ま20 たはカルボキシル基の少なくとも一部を、酸の作用により開裂しうる保護基で修飾したもの、すなわち、水酸基またはカルボキシル基中の水素原子の少なくとも一部を、こうした保護基で置換したものが、本発明のレジスト組成物におけるアルカリ可溶性樹脂となりうる。保護基としては、以下の構造のものが好ましい。

[0028]

【0030】ここで、直鎖状アルキルとしては、例えば 炭素数1~5のものが挙げられ、分枝状アルキルとして は、例えば炭素数3~8のものが挙げられ、環状アルキルとしては、例えば炭素数5~16のものが挙げられ、 30 これはシクロアルキルの他、シクロアルキルアルキルで あってもよく、アルケニルとしては、例えば炭素数2~7のものが挙げられ、アリールとしては、例えば、スフェニル、トリル、キシリルなど、炭素数6~16のものが挙げられ、アラルキルとしては、例えば、ベンジル、モノまたはジメチルベンジル、フェネチルなど、炭素数7~16のものが挙げられ、またアルコキシとしては、例えば炭素数1~5のものが挙げられる。これらの悲は置換基を有していてもよく、例えば、直鎖状アルキル、分枝状アルキルまたはアルケニルに置換してもよい基としては、ハロゲンなどが挙げられ、環状アルキルを構成す

るシクロアルカン環に置換してもよい基としては、ハロ ゲンなどが挙げられ、アリールまたはアラルキルを構成 するベンゼン環などの芳香環に置換してもよい基として は、ハロゲンやニトロなどが挙げられる。またもちろ ん、ここでいうシクロアルカン環や芳香環には、上記炭 素数の範囲内でアルキルなどの炭化水素基が結合してい てもよい。

【0031】本発明のレジスト組成物は、以上説明した アルカリ可溶性樹脂および酸発生剤を含有するものであ るが、その他必要に応じて、電子供与体、溶解阻止剤、 増感剤、染料、接着性向上剤、塩基性物質など、この分 野で使用されている通常の添加物を含有することもでき る。またレジスト組成物は、全固形分重量を基準に、ア ルカリ可溶性樹脂が40~95重量%の範囲、酸発生剤 が 0.1~20 重量%の範囲で配合されているのが好まし 11

【0032】本発明のレジスト組成物は、通常、全固形 分濃度が10~50重量%となるよう、上記各成分を溶 剤に混合してレジスト液が調製され、シリコンウェハー などの基体上に塗布される。ここで用いる溶剤は、各成 20 分を溶解するものであればよく、この分野で通常用いら れているものであることができる。例えば、エチルセロ ソルブアセテート、メチルセロソルプアセテート、プロ ピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールモノエチルエーテルアセテートのよう なグリコールエーテルエステル類、エチルセロソルブ、 メチルセロソルブ、プロピレングリコールモノメチルエ ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ エチレングリコールジメチルエーテルのようなグリコー ルモノまたはジエーテル類、乳酸エチル、酢酸ブチル、 ピルビン酸エチルのようなエステル類、2-ヘプタノ ン、シクロヘキサノン、メチルイソブチルケトンのよう なケトン類、キシレンのような芳香族炭化水素類などが 挙げられる。 これらの溶剤は、それぞれ単独で、また は2種以上組み合わせて用いることができる。

[0033]

【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら 限定されるものではない。例中、含有量ないし使用量を 表す%および部は、特にことわらないかぎり重量基準で 40 ある。

【0034】合成例1

200mlの四つロフラスコに、ニオキシム2.86g、 (+) -10-カンファースルホニルクロリド10.44 g、およびアセトン66.45gを仕込み、25℃で30 分間攪拌したあと、トリエチルアミン4.29gを10分 かけて滴下した。滴下終了後、3時間攪拌し、次に酢酸 0.75 gおよびトリエチルアミン1.01 gを添加し、さ らに 1 時間攪拌したあと、反応マスを濾過した。濾過物 をアセトン20gで洗浄し、この濾液および洗液を合わ 50 像度を求めたところ、0.26 μm であった。

せて、そこへ酢酸エチル180gおよびトルエン140 gを加え、次に400gの蒸留水で2回洗浄した。その 後、1.71 gの酢酸ナトリウムを200gの蒸留水に溶 かした水溶液を有機層に加えて洗浄し、さらにこの有機 層を200gの蒸留水で4回洗浄した。有機層を濃縮 し、得られた澱縮物13.18gにトルエン13gおよび n-ヘキサン7.27gを加えて、析出した固体を濾別し た。このウェットケーキを室温で一昼夜減圧乾燥して、 3.16 gのO, O'-ピス(10-カンファースルホニ ル)ニオキシムを得た。

[0035]

質量分析: SIMS(FAB) 571 (M+H) 「H-NMR (ジメチルスルホキシド) δ (ppm) : 0.8 1 (s, 6H); 1.01 (s, 6H); 1.39-1.47 (m, 2H); 1.54-1. 64 (m, 2H); 1.71 (brs. 4H); 1.92-2.01 (m, 4H); 2.06 -2. 10 (m, 2H); 2. 16-2. 25 (m, 2H); 2. 31-2. 41 (m, 2 H); 2. 78-2. 83 (m, 4H); 3. 48-3. 74 (m, 4H).

【0036】適用例1

特開平 5-181279 号公報に記載の方法により得られ、ポ リ (p-ビニルフェノール) 中の水酸基のうち26モル %がtert-ブトキシカルボニルメチルエーテル化された ポリマー 1 3.5部、O, O′-ビス(10-カンファー スルホニル) ニオキシム1.0部、電子供与体として2-ヒドロキシカルバゾール 0.27部、および塩基性物質と して2,6-ジイソプロピルアニリン0.054部を、プ ロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート62 部に混合溶解し、孔径 0.2μm のフッ素樹脂製フィルタ ーで濾過して、レジスト液とした。

【0037】常法により洗浄したシリコンウェハーに、 スピンコーターを用いて上記レジスト液を回転塗布し、 乾燥後の膜厚が 0.539μm のレジスト膜を形成させ た。次いで、このシリコンウェハーをホットプレート上 にて、100℃で90秒間プリベークした。プリベーク 後の塗膜を、パターンを有するクロムマスクを介して、 248nmの露光波長を有する KrFエキシマーレーザース テッパー ((株) ニコン製の "NSR-1755 EX8A"、NA=0.4 5 〕を用いて露光した。露光後のウェハーを、ホットプ レート上にて100℃で90秒間加熱して、PEBを行 った。これを、テトラメチルアンモニウムハイドロオキ サイドの2.38%水溶液で現像して、ポジ型パターンを 得た。得られたポジ型パターンにつき、以下のようにし て評価し、それぞれの結果を得た。

【0038】感度: 0.3µm ラインアンドスペースの 断面を走査型電子顕微鏡で観察し、ベストフォーカスに おけるラインアンドスペースが1:1になる露光量から 感度(実効感度)を求めたところ、60ml/cm2であっ た。

【0039】解像度: 実効感度の露光量において膜減 りなく分離する最小のラインアンドスペースの幅から解

【0040】プロファイル: 実効感度の露光量におけ る 0.3 μm ラインアンドスペースの断面形状を走査型電 子顕微鏡で観察したところ、パターンがほぼ垂直に切れ [0044] ており、パターントップの平坦部も明瞭に観察された。 【表1】

【0041】小パターン倒れ: 露光後1時間放置し、 次いでPEBを行った試料につき、レジストパターンの 倒れ具合を観察したところ、パターン倒れは認められな かった。

【0042】適用例2

適用例1におけるポリ (p-ビニルフェノール) 中の水 10 酸基のうち26モル%がlertーブトキシカルボニルメチ ルエーテル化されたポリマーに代え、ポリ(p-ピニル フェノール) 中の水酸基のうち23モル%がtertープト キシカルボニルメチルエーテル化されたポリマーを同量 用い、レジスト液の回転塗布、乾燥後の膜厚が 0.653 μπ であった以外は、適用例1と同様に操作して、ポジ 型パターンを得た。得られたポジ型パターンにつき、適 用例1と同様の方法で、感度、解像度およびプロファイ ルを評価し、結果を表1に示した。

【0043】比較例1

適用例2における〇、〇′ービス(10ーカンファース ルホニル)ニオキシムに代え、ビス(シクロヘキシルス ルホニル) ジアゾメタンを同量用いた以外は、適用例2 と同様に操作して、ポジ型パターンを得た。得られたポ ジ型パターンにつき、適用例1と同様の方法で、感度、

解像度およびプロファイルを評価し、結果を表1に示し

10

例 No.	感 度	解像度	プロファイル
適用例2	40 mJ/cm²	0. 28 / L m	А
比較例1	228 mJ/cm ²	0. 29 /£ m	В

【0045】(表1の脚注)

'プロファイルA:裾部に若干の広がりが認められる以 外は、ほぼ垂直に切れており、パターントップの平坦部

プロファイルB:裾広がりの山型で、パターントップの 平坦部なし

[0046]

【発明の効果】本発明のグリオキシム系エステルは、レ ジスト用の酸発生剤、特に、酸の作用により開裂しうる 20 保護基を有するアルカリ可溶性樹脂を含むレジスト用の 酸発生剤として有用である。そして、この化合物を酸発 生剤として用いたレジスト組成物は、耐熱性、残膜率、 塗布性などの諸性能が高い水準に維持され、また感度、 解像度およびプロファイルに優れ、タイム・ディレイ効 果も抑制される。